









	<h2 style="color: red;">FDB035AN06A0</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB035AN06A0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB035AN06A0.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 40318 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB035AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	40318 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB035AN06A0CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	124nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 22A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta), 80A (Tc)

FDB035AN06A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB035AN06A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB035AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB035AN06A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB035AN06A0 FAIRCHI FDB035AN06A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDB0300N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB031N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0300N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>
 <p>FDB035AN06A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A TO-263AB</p>	 <p>FDB035AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A TO-263AB</p>	 <p>FDB035AN06_F085 FAIRCHILD FDB035AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB031N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>

FDB035AN06A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB035AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB035AN06A0 Datenblatt	FDB035AN06A0-Datenblätter	FDB035AN06A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB035AN06A0
FDB035AN06A0 Electronic	FDB035AN06A0-Komponenten	FDB035AN06A0-Verteiler	FDB035AN06A0-Bild	FDB035AN06A0-Teil
FDB035AN06A0 Preis	FDB035AN06A0 Hersteller	FDB035AN06A0 Bild	FDB035AN06A0 Aktie	FDB035AN06A0 Inventar
FDB035AN06A0 Neu	FDB035AN06A0 Original	FDB035AN06A0 garantiert	FDB035AN06A0 RFQ	FDB035AN06A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited